

Кремний (Si)

**Производитель:**

АО «Диполь Технологии»

Цена:

Цена по запросу

Описание

Монокристаллический кремний – основа для производства полупроводниковых приборов. ИМЭ на основе Si составляет 98% всех производимых в мире полупроводниковых приборов.

Кремний имеет оптимальное значение ширины запрещенной зоны, которая обусловила достаточно низкую концентрацию собственных носителей и высокую рабочую температуру.

Применение

Полупроводники из кремния широко применяются для создания интегральных микросхем, биполярных и полевых транзисторов, приборов с зарядовой связью, быстродействующих фотодиодов и многих других устройств. А продукты на основе кремния, такие как MOSFET или IGBT-транзисторы с суперпереходом, можно использовать в широком диапазоне напряжений (от единиц до нескольких сот вольт) и в различных классах мощности.

Спецификация

Диаметр	2"	3"
Метод выращивания		
Ориентация		
Тип проводимости / легирующая примесь		
Толщина (мкм)	279	380
Удельное сопротивление (Ω·см)	MCZ: 1-10	
TTV (мкм)		
Bow/Warp (мкм)		

Подложки Si с другими параметрами доступны по запросу. Доступны слитки и эпитаксиальные структуры на основе Si. Производство: Китай.